

Сведения о ведущей организации
по диссертации **Тарелкина Сергея Александровича**
«Исследование слоистых структур на основе легированных бором монокристаллов алмаза
для применения в полупроводниковой электронике»
по специальности 01.04.10 – Физика полупроводников

Полное наименование организации в соответствии с уставом	Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт физики твердого тела Российской академии наук
Сокращенное наименование организации в соответствии с уставом	ИФТТ РАН
Место нахождения	Московская область, г. Черноголовка
Почтовый индекс, адрес организации	142432, г. Черноголовка, Московская обл., ул. Академика Осипьяна, д. 2
Веб-сайт	http://www.issp.ac.ru
Телефон	8(496)52 219-82
Адрес электронной почты	tan@issp.ac.ru
Список публикаций сотрудников ИФТТ РАН по теме диссертации соискателя в рецензируемых научных изданиях за последние 5 лет	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pitchaimuthu S., Marappan S., Kharton V. Materials for energy technologies: Recent developments and trends // Materials Letters. 2019. Vol. 253. P. 195. 2. Guseynov R.R. et al. Electrical and Optical Properties of Unrelaxed InAs1-xSbx Heteroepitaxial Structures // Semiconductors. 2019. Vol. 53, № 7. P. 906–910. 3. Rabinovich D.S. et al. Magnetoelectric effects in superconductor/ferromagnet bilayers // Phys. Rev. B. 2019. Vol. 99, № 21. P. 214501. 4. Shvetsov O.O. et al. Non-linear Hall Effect in Three-dimensional Weyl and Dirac Semimetals // JETP Letters. 2019. 5. Shashkin A.A., Kravchenko S.V. Recent developments in the field of the metal-insulator transition in two dimensions // Applied Sciences (Switzerland). 2019. Vol. 9, № 6. 6. Polyakov A.Y. et al. Electrical Properties, Deep Levels and Luminescence Related to Fe in Bulk Semi-Insulating β-Ga 2 O 3 Doped with Fe // ECS J. Solid State Sci. Technol. 2019. Vol. 8, № 7. P. Q3091 7. Brantov S.K., Yakimov E.B. Thermoresistive Semiconductor SiC/Si Composite Material // Semiconductors. 2019. Vol. 53, № 2. P. 220–223. 8. Piatrusha S.U. et al. Noise Insights into Electronic Transport // JETP Letters. 2018. Vol. 108, № 1. P. 71. 9. Orlov V.I., Yakimov E.B., Yarykin N. Dislocation trails in Si: Geometry and electrical properties // Physica Status Solidi (C) Current Topics in Solid State Physics. 2017. Vol. 14, № 7. 10. Orlov V.I. et al. Study of Low Voltage Prebreakdown Sites in Multicrystalline Si Based Cells by the LBIC, EL, and EDS Methods // Advances in Condensed Matter Physics. 2017. Vol. 2017. P. 1–5. 11. Khorosheva M.A., Kveder V.V., Seibt M. On the nature of defects produced by motion of dislocations in silicon // Physica Status Solidi (A) Applications and Materials Science. 2015. Vol. 212, № 8. P. 1695–1703.

«Верно»

Ученый секретарь ИФТТ РАН
к.ф.-м.н.



Терещенко Алексей Николаевич